PRODUCTION OF SILICON TETRACHLORIDE

Patent Number:

JP62017012

Publication date:

1987-01-26

Inventor(s):

OKUYA TAKESHI; others: 02

Applicant(s):

AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

Requested Patent:

☐ JP62017012

Application Number: JP19850154861 19850712

Priority Number(s):

IPC Classification:

C01B33/107

EC Classification:

Equivalents:

JP1654013C, JP3057047B

Abstract

PURPOSE:To produce easily high-purity SiCl4 by allowing the ashes obtained by burning biomass silicate to react with a Cl2-contg. carbon compd.

CONSTITUTION: The following mixture is allowed to react with each other at 400-1,100 deg.C in the inert or reducing atmosphere which consists of both the ashes obtained by burning biomass silicate consisting of vegetable contg. silica content such as rice hull and straw or a carbonization-treated product obtained by subjecting the silicic acid biomass to the carbonization treatment and a Cl2-contg. carbon compd. (e.g. CCl4) or a mixture of Cl2 and C-contg. compd. (e.g. CO).

Data supplied from the esp@cenet database - 12

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-017012

(43) Date of publication of application: 26.01.1987

(51)Int.CI.

C01B 33/107

(21)Application number : **60-154861**

(71)Applicant: AGENCY OF IND SCIENCE &

TECHNOL

(22) Date of filing:

12.07.1985

(72)Inventor: OKUYA TAKESHI

NAKADA YOSHINORI

GOTO FUJITARO

(54) PRODUCTION OF SILICON TETRACHLORIDE

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce easily high-purity SiCl4 by allowing the ashes obtained by burning biomass silicate to react with a Cl2-contg. carbon compd.

CONSTITUTION: The following mixture is allowed to react with each other at 400W1,100°C in the inert or reducing atmosphere which consists of both the ashes obtained by burning biomass silicate consisting of vegetable contg. silica content such as rice hull and straw or a carbonization-treated product obtained by subjecting the silicic acid biomass to the carbonization treatment and a Cl2-contg. carbon compd. (e.g. CCl4) or a mixture of Cl2 and C-contg. compd. (e.g. CO).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62 - 17012

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和62年(1987) 1月26日

C 01 B 33/107

6526-4G

審査請求 有 発明の数 2 (全4頁)

4 発明の名称

四塩化ケィ素の製造方法

创特 昭60-154861

22出 願 昭60(1985)7月12日

@発 明 奥 者

札幌市豊平区月寒東2条17丁目2番1号 工業技術院北海

道工業開発試験所内

⑫発 明 中 H 徳

谷

札幌市豊平区月寒東2条17丁目2番1号 工業技術院北海

道工業開発試験所内

勿発 明 後藤 藤 太 郎 札幌市豊平区月寒東2条17丁目2番1号 工業技術院北海

切出 頭 人

工業技術院長

砂指定代理人

工業技術院北海道工業開発試験所長

1. 発明の名称

四塩化ケイ素の製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) ケイ酸パイオマスを燃焼処理し、得られた灰 分を、400~1100℃で含塩素炭素化合物又は塩素 と含炭素化合物の混合物と反応させることを特徴 とする四塩化ケイ素の製造方法。
- (2) ケイ酸パイオマスを炭化処理した後、铅られ た炭化処理生成物を、400~1100℃で含塩素炭素 化合物又は塩素と含炭素化合物の混合物と反応さ せることを特徴とする四塩化ケイ素の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本苑明はもみがら及び/又は稲わらなどのケイ 酸パイオマスを原料とする四塩化ケイ素の製造方 法に関するものである。

〔從來技術〕

四塩化ケイ素(SiCl4)は、沸点が56.8℃の物質 であり、精密蒸留技術を適用することにより、超 高純度に精製することができる物質である。

四塩化ケイ素は、トリクロロシラン(NSiCla)、 シラン(SiH 4)、ケイ素金属(Si)、シリカ(SiO 2) 種のケイ素誘導体に容易に転換させることが可能 である極めて有用な物質であり、各種の分野にお いて広く利用されている。例えば、これらの誘連 体のうち、トリクロロシランはシリコーンゴム、 シリコーングリース等の有機ケイ素の素材、Si金 属は半導体や太陽電池素材として用いられるアモ ルファスケイ素原料、及びシリカは光ファイバー 素材等として利用されている。

電子工業分野に用いられるケイ素製品や、有機 ケイ素工業分野で用いられるシリコーンは、高純 度のものであることが要求されるが、このような 高純度のケイ素製品を得るには、従来、次のよう な方法が一般的に行われている。即ち、ケイ砂、 ケイ石、石英粉末等のケイ素純度の高い鉱物を原 料とし、これを還元剤としての炭素材の存在下、 2000℃以上に加熱させた電気炉で還元して金属ケ

イ素となした後、この金属ケイ素に塩化水素を反 応させてトリクロロシランを製造し、トリクロロ シランを特別により高純度のものとなし、そして. この高純度トリクロロシランを原料として各種の ケイ素製品を得ている。また、電子材料関係で用 いられるようなより高越度のケイ素製品を得る場 合には、ケイ素原料として水晶が用いられる。

ところで、前記のような高純度のケイ崇原料を 将来にわたって安定的に確保することはむつかし く、従って、姿顔的に安定に供給され、かつ高純 度のケイ素製品を与える新しいケイ素資源の探索、 確保及びその処理プロセスの開発が必要となるが、 現在のところ未だ有効なプロセスは見出されてい

[] 的)

見られる前記のような事情に鑑み、新しいケイ素 資源の探索及び処理プロセスの開発について鋭意 研究を重ねた結果、稲、麦などのもみがらやワラ、 笹の蓮、トウモロコシの蓮、クキなどにはシリカ

通常、400~1100℃程度であり、塩素化剤として は、四塩化炭素やテトラクロロエチレン、ホスゲ ン等の含塩素炭素化合物、あるいは、塩素と、一 酸化炭素、炭化水素、塩化炭素、塩化炭化水素な どの含炭素化合物との混合物が用いられ、その組 合せ、種類は特に飼約されない。従って、反応系 中に炭素は固体ではなく、塩素と結合した気体状 想あるいはCO、CH 4 のような気体として供給され るために試料中のSiO2との接触は固体炭素の場 合よりは良好である。さらに、発明者らの研究で は、従来のSiOzと炭素との混合物からなる固体 と純塩素ガスを接触させて、塩素化反応を行わせ る場合、塩素が直接SiO2と反応するのではなく、 塩素と炭素が反応し、塩化炭素を生成し、これが SiO2と反応することが判明した。

これらの事実より、SiO2の塩素化反応では、 従来法であるSiO2と固体の炭素の混合物を純塩 素ガスで反応させる方法より、炭化塩素など炭素 分が塩素と結合した気体状態の含塩素炭素化合物 又は塩素と、一酸化炭素、炭化水素などの含炭素

分が多量に含まれており、ケイ素資源として極め て有効であることを見出すと共に、その処理プロ セスの開発について鋭意研究の結果、本発明を完 成するに到った。

〔樽 成〕

即ち、本発明によれば、ケイ酸パイオマスを原 料とし、これを燃焼処理ないし、炭化処理し、得 られた処理生成物を含塩素炭素化合物又は塩素と 含炭素化合物の混合物で反応処理することを特徴 とする四塩化ケイ素の製造方法が提供される。

本発明でいうケイ酸パイオマスとは、シリカ分 を含む植物(ケイ酸植物)又はその葉、茎等の部分 を意味し、稲、麦などのもみがらやワラ、笹の葉、 トウモロコシの葉や茎等が包含される。

従来のように、鉱物中のSiO2を塩素化する場 本発明者らは、高純度ケイ素製品の製造分野に、 合、コークス、木炭などの炭素度物質を、SiO2 粉末と混合し、軌塩素ガスで塩素化処理に供する が、この場合、炭素質物質の表面積、細孔分布な どの物理特性が、塩素化反応性に大きな影響を与 える。本発明で用いるられる塩素化処理温度は、

> 化合物とのガス混合物を直接SiOzと反応させる 方が効率的であることが見出された。

塩素化に供するケイ酸パイオマスの処理方法と しては、燃焼処理及び炭化処理の二つの方法が採 用できる。ケイ酸パイオマスを燃焼処理する場合、 炭素は全くSiO2中に含まれていないが、本発明 では、含塩素炭素化合物、又は塩素と含炭素化合 物との混合物を塩素化剤として用いるために、 SiO 2 の四塩化ケイ素への転化率は、従来法の SiO2と炭素混合物に、純塩素ガスを作用させる 場合の転化率よりも高い値を示した。

ケイ酸パイオマスに対して炭化処理を施す場合、 ケイ酸バイオマスの完全燃焼を回避して熱処理を 行えばよく、その際の熱処理温度は、通常200~ 1100℃である。また、この場合、熱処理雰囲気と しては種々のものが用いられるが、一般には不活 性雰囲気又は還元性雰囲気が採用され、例えば、 窒素、アルゴン、水素、一酸化炭素、スチーム、 燃焼廃ガス等が単独又は混合物の形で用いられ、 また、低温度の熱処理では空気等を用いることが

できる.このような炭化処理によって、ケイ酸バ イオマス中の有機物は炭化され、ケイ素分と炭素 分を含む炭化処理生成物が得られる。この場合、 炭化条件を調節することにより、シリカ分と炭素 分との混合比を調節することができる。炭化処理 生成物中に含まれるケイ素分と炭素は、同一の生 体系中の物質に由来するため、そのケイ素分と炭 素の混合性は分子次元で混ざり合っているものと 推定でき、しかも、各々超微粒子である。従って、 前記炭化処理生成物は表面積、細孔分布などの物 理特性等において、塩素化反応性に非常に含む物 質であるものと考えられる。これらの点より、本 発明の場合、塩素化温度、反応時間を、従来の SiOzと固体炭素の混合物を用いる塩素化の場合 よりも、著しく低く、かつ短くすることが可能で . ある. . . .

本発明においては、四塩化ケイ素は、ガス状の 生成物として得られるが、この四塩化ケイ素は、 精団により容易に高純度のものとすることができ る。例えば、もみがらを800℃で流動燃焼した場

できる.

el. . . ar >

〔実施例〕

次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明 する。

実 施 例

もみがらを、窒素気流中において、900℃で1時間炭化処理を施して、炭化処理生成物を得た。このものは、SiO 2 換算で37.5重量%のケイ素を含有した。次に、この炭化処理生成物を、四塩化炭素気流中で、600~900℃で5~180分間塩素化処理を行った。この塩素化処理におけるケイ素分のSiC1 4 への転化率を、反応温度との関連で表ー1に示す。また、比較のために、もみがら炭化処理物の塩素化実験で、塩素化剤として純塩素ガスを用いた結果を表ー2に示した。

さらに、比較のために、市阪のSiO2と炭素との重量比1:1の混合物及びSiCの塩素化を純塩素ガスを用いて行い、その結果をそれぞれ表 - 3及び表 - 4に示す。表 - 1~表 - 4に示した反応結果からわかるように、本発明により、もみがらを原

合、得られる灰分の組成(%)は、一般的に、SiO 2:96.65、C:0.96、P 2 0 6:0.12、K 2 0 及びNa 2 0:0.80、Cao:0.46、Mn0:0.10、MgO:0.08、Fe 2 0 3:0.15、Al 2 0 3:0.59である。従って、もみがらや稲わらを塩素化処理した場合、ケイ素分の他、リン、鉄、及びアルミニウムが揮発性塩化物となり、その他のものは反応残渣中に残留する。そして、得られた揮発性塩化物は各々沸点が異なるため、精密蒸留により、容易に高純度の四塩化ケイ素を分離回収することができる。

(効果)

本発明で原料として用いている稲、安のもみがら及びわらなどのケイ酸パイオマスは、シリカ鉱物資源であるケイ石、ケイ砂等とは異なり、毎年、稲作、安作などにより得ることができ、しかも農業廃棄物でもあるため、その原料供給には特に問題はなく、その上、本発明により得られる四塩化ケイ素は、精密蒸留により容易に高純度のものとすることができるので、本発明の方法は、将来にわたって有効なケイ素製品製造技術ということが

料として用い、その中に含まれているケイ素分をSiC14へ転化する方が、他の原料を用いる場合よりも、大きな転化率を得ることができ、さらに、塩素化剤として純塩素ガスを用いるよりも四塩化炭素を用いる方が大きな転化率を得ることができる。また、本発明によりもみがら中のシリカ分を塩素化する場合には、反応がはやく、800℃及び900℃では、5分間程度ですでに180分の転化率と同程度の転化率を得ることができる。これに対し、900℃、10分間の条件では、SiO2/炭素混合物は1 重量%及びSiCは10重量%の転化率を示したにすぎなかった。

表 - 1

夹	反応	もみがらケイ素分転化率(重量%)						
驗	温度	ž.	E F	応 時 間 (分)				
No	(°C)	5	10	30	60	120	180	
1	600	40.6	40.8	45.2	47.0	56.0	58.0	
2	700	58.3	61.2	63.9	68.5	67.8	69.2	
3	800	72.6	75.0	80.7	80.1	78.9	79.6	
4	900	88.0	87.8	87.6	89.0	90.3	90.5	

実	反応	もみがらケイ素分転化率(重量%)					
験	温度	反 応 時 間(分))	
No	(℃)	5	10	30	60	120	180
1	600	30.4	31.1	35.4	36.5	44.0	45.2
2	700	47.6	50.9	55.9	57.3	61.5	58.3
3	800	65.5	66.9	74.4	73.4	72.1	71.0
4	900	82.5	82.0	\$3.4 73.4	73.2	82.5	85.4

実験	反応温度	SiC标化率(重量%)
Νο	(℃)	反応時間:180分
1	700	0
2	800	12.1
3	900	68.2

表 - 3

特許出願人 工業技術院長 等 々 力 達 指定代理人 工業技術院北海道工業開発試験所長

25 75 -- Au

実験	反応温度	SiO 2 転化率 (重量%)
Νo	(℃)	反応時間:180分
1	600	5.8
2	700	49
3	800	4.9
4	900	4.8

BEST AVAILABLE COPY